低パラジウム無電解ニッケルめっきプロセス
Low Palladium Type Electroless Nickel Plating Process

IPTプロセス
IPT PROCESS

- ●パラジウム吸着量が低くても、高い反応性
  Reduce palladium adsorption amount, high deposition ability
- ●選択めっき性が良好
  High plating selectivity
- ●含リン率が高い無電解ニッケル皮膜(7%)によって、接点溶解による不良を抑制
  High phosphorus content (7% by weight), prevent plating failures near contact points

低いパラジウム吸着量でも高い反応性
Low palladium adsorption amount, high deposition ability

PC/ABSのブタジエンの比率が少ない難めっき部
Difficult plating area of PC/ABS (Butadiene ratio: low)

浴中のパラジウム濃度：15mg/L (30℃, 3分)
Palladium concentration in catalyst solution min

IPTプロセス IPT PROCESS

パラジウム吸着量：29.3μg/dm²
Palladium adsorption amount

従来プロセス Conventional process

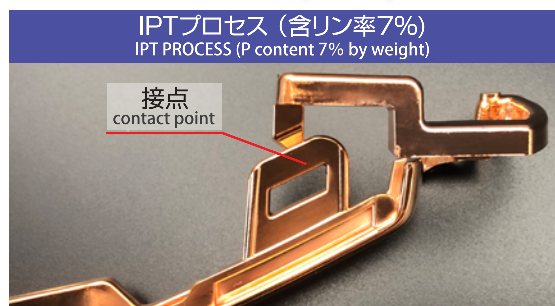
パラジウム吸着量：42.6μg/dm²
Palladium adsorption amount

良好な選択めっき性
Can deposit selectively

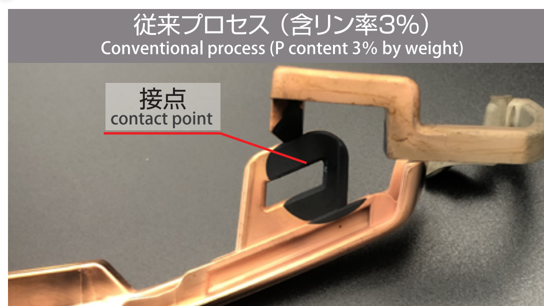
	IPTプロセス IPT PROCESS	従来プロセス Conventional process
PCに対するパラジウム吸着量 Palladium adsorption amount to PC	12.9μg/dm²	25.8μg/dm²
二色成形品 Two-color molding めっき外観 Appearance after plating		
見切り Plating selectivity	○	×

無電解ニッケル皮膜による接点不良を抑制
Prevent failure near contact points by electroless nickel plating films

IPTプロセス（含リン率7%） IPT PROCESS (P content 7% by weight)



従来プロセス（含リン率3%） Conventional process (P content 3% by weight)



※硫酸銅めっきをスロースタートなしで通電（10A/dm²）
After acid copper plating without slow start

皮膜の溶解を防ぎ、良好なめっき外観が得られる
Prevent film dissolution, great appearance films can be obtained